ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ

УДК 539.233

ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ MgO(111) КАК ПОДЛОЖКИ ДЛЯ НАНЕСЕННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ Au В ПРОЦЕССАХ АДСОРБЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛ CO, NO, O₂

© 2020 г. Т. Т. Магкоев^{*a,b,**}, Г. С. Григоркина^{*a*}, В. Б. Заалишвили^{*b*}, О. Г. Бурдзиева^{*b*}, Е. Н. Козырев^{*b*}, Г. Э. Туаев^{*b*}, К. Fukutani^{*c*}

^aСеверо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия ^bРоссийская академия наук, Владикавказский научный центр, Геофизический институт, Владикавказ, Россия ^cUniversity of Tokyo, 153-8505, Tokyo, Japan

*e-mail: t_magkoev@mail.ru Поступила в редакцию 17.01.2019 г. После доработки 13.06.2019 г. Принята к публикации 18.06.2019 г.

Комплексом методов анализа поверхности в условиях сверхвысокого вакуума проведено сравнительное исследование процессов формирования наноразмерных кластеров золота на поверхности пленок MgO(111), с одной стороны, и MgO(100) – с другой, а также процессов адсорбции и взаимодействия молекул CO, NO, O₂ на поверхности соответствующих металлооксидных систем – Au/MgO(111) и Au/MgO(100). Показано, что частицы золота размером 2–3 нм, нанесенные на поверхность пленки MgO(111), приобретают эффективный положительный заряд в результате переноса электронной плотности в сторону подложки для стабилизации некомпенсированного дипольного момента полярной поверхности MgO(111). Такое состояние данной металлооксидной системы проявляется в более эффективном процессе окисления молекул CO, как кислородом, так и соадсорбированными молекулами NO, по сравнению с системой на основе неполярной поверхности MgO(100).

Ключевые слова: адсорбция и взаимодействие молекул, оксид углерода, оксид азота, кислород, металлооксидные системы, наноразмерные кластеры золота, оксид магния, методы анализа поверхности, сверхвысокий вакуум

DOI: 10.31857/S0044453720010203

В последнее время изучение металлооксидных систем, образованных нанесением наноразмерных кластеров металлов на поверхности оксидов, привлекает повышенный интерес благодаря особым физико-химическим свойствам таких систем, определяемых самим нанокластером металла, с одной стороны, и межфазной границей раздела металл/оксид – с другой [1, 2]. Атомная структура и электронное состояние нанесенных кластеров металлов определяется состоянием оксидной подложки. Изменяя последнее тем или иным образом, можно настраивать свойства металлического кластера, границы раздела металл/оксид и, тем самым, свойства системы в целом. Такая настройка может иметь существенную прикладную значимость, в частности, при разработке металлооксидных гетерогенных катализаторов с новыми или улучшенными свойствами [3]. С учетом этого, было бы интересным в качестве оксидной подложки выбрать объект, обладающий присущей ему особенностью, например,

оксид магния с ориентацией поверхности полярной грани – MgO(111). Данная поверхность кристалла MgO является нестабильной вследствие некомпенсированного дипольного момента и релаксирует с образованием фасеток стабильной структуры MgO(100) [4]. В виде же тонкой пленки структура MgO(111) может быть сформирована на ориентирующей подложке с близкими параметрами решетки. В качестве такой подложки может быть использована поверхность кристалла Мо(110) [4–6]. В отличие от свойств неполярных граней MgO – (100), (110), адсорбционные свойства поверхности MgO(111) остаются практически неизученными. В связи с этим, цель настоящей работы — установление характера адсорбции и взаимодействия молекул оксида углерода (СО), оксида азота (NO) и кислорода (O₂) на поверхности системы, образованной нанесением наноразмерных кластеров Au на поверхность MgO(111). Для более наглядного установления особенностей, присущих MgO(111), проведено сопоставление с результатами, полученными в настоящей же работе для поверхности MgO(100).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследования проведены в трехуровневой сверхвысоковакуумной системе на основе установки VG Escalab MkII с использованием методов электронной оже-спектроскопии (ЭОС) на основе однокаскадного анализатора цилиндрического зеркала с коаксиальной пушкой. дифракции мелленных электронов (ДМЭ) с применением станчетырехсуточной дартной полусферической электронной оптики, инфракрасной фурье-спектроскопии (ИКС), термодесорбционной спектроскопии (ТДС) с применением квадрупольного масс-спектрометра HMT Hiden Analytical, атомно-силовой микроскопии (ACM) (Omicron Nanoprobe) и метода тормозящего электронного пучка измерения работы выхода ф (метод Андерсона). Метод ИКС на основе прибора Nicolet-Nexus 860 реализован в геометрии скользящего р-поляризованного луча (угол падения на исследуемую поверхность 85 градусов), позволяющей регистрацию колебательных мод адсорбированных молекул, обладающих ненулевым динамическим дипольным моментом вдоль нормали к поверхности. Пленки оксида магния различной поверхностной ориентации формировались на поверхности подложек Мо(110) и Мо(100) термическим напылением из ячейки Кнудсена сверхчистого оксида (99.999%). Выбор кристалла Мо в качестве ориентирующей подложки для роста оксида магния обусловлен близостью параметров их кристаллических решеток. Скорость роста пленки оксида магния определялась количеством напыляемого вещества, измеряемым кварцевым резонатором, и сопоставлением с ослаблением интенсивности оже-сигнала подложки Мо MNV. Покрытие (Θ) MgO принималось равным одному эквивалентному монослою ($\Theta = 1$ MLE) при поверхностной концентрации частиц $n = 1.5 \times 10^{15}$ см⁻². По данным ДМЭ при скорости роста пленки оксида магния 0.5 MLE/мин на поверхности Mo(100), поддерживаемой при температуре 600 К, пленка приобретает структуру MgO(100) при покрытии, превышающем 2 MLE (рис. 1а). Напыление на поверхность Мо(110) при тех же условиях приводит к формированию структуры MgO(111) (рис. 1б). При этом структура поверхности MgO(111), в отличие от MgO(100), сохраняется при толщине пленки, не превышающей 6 MLE. При больших толщинах структура MgO(111) разупорядочивается вследствие ослабления ориентирующего влияния подложки с формированием фасеток более стабильной структуры MgO(100). Атомы Au наносились на поверхность пленки оксида магния, поддерживаемой при комнатной температуре, термическим напылением из ячейки Кнудсена (чистота навески Аи: 99.9999%). Поверхностная концентрация атомов Аи определялась кварцевым резонатором и контролировалась по ослаблению оже-линии подложки, О KVV. Поверхностная концентрация 1.45 × 10¹⁵ см⁻² принималась равной одному эквивалентному монослою 1 MLE Аи. Как видно из результатов АСМ-измерений (рис. 1в, 1г), эффективный размер кластеров Аи при покрытии 0.07 MLE составляет 2-3 нм (в), а при покрытии 30 MLE – 90–100 нм (г). Формирование трехмерных островков Аи на поверхности пленок MgO толщиной в 6 монослоев и выше согласуется с литературными данными. Согласно обобщениям, приведенным в обзоре Нилиуса [7], общепринята следующая точка зрения: для массивных оксидов или их пленок толщиной более 2-3 монослоев, сформированных на металлических подложках, преимущественным механизмом роста служит формирование трехмерных металлических кластеров, начиная с самых малых покрытий. Для пленок же толщиной 2-3 монослоя первоначально формируются двумерные металлические кластеры, что обусловлено эффективным переносом заряда из металлической подложки на металлический кластер посредством туннелирования сквозь тонкую оксидную прослойку. Образующиеся таким образом отрицательные ионы, например, Аu⁻ на поверхности MgO/Ag(100), более эффективно взаимодействуют с подложкой, что приводит к преимущественному формированию двумерных кластеров. В целом, считается, что толщина оксидной прослойки играет одну из ключевых ролей в настройке морфологии нанесенных кластеров металлов и каталитической активности металлооксидных систем [8]. Для изучения адсорбции оксида углерода (CO), оксида азота (NO) и кислорода (O_2) на поверхности формируемых металлооксидных систем соответствующие газы высокой степени чистоты напускались в сверхвысоковакуумную камеру через высокоточные вакуумные натекатели. Время выдержки в атмосфере газа при парциальном давлении 10⁻⁶ Торр в течение 1 с принималось равным экспозиции газа 1 Ленгмюр: 1L = $= 10^{-6}$ Торр с. Держатель образцов, на котором смонтированы кристаллы Мо(110) и Мо(100), позволял их охлаждение до температуры 90 К и прогрев до 2700 К.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Морфология пленок Au на поверхности MgO(100) и MgO(111) при указанных покрытиях Au качественно подобна. Вместе с тем, несмотря на это подобие, электронные состояния кластеров Au, нанесенных на MgO(111) и MgO(100), заметно отличаются. Это наиболее заметно для кластеров малых размеров, о чем свидетельствует поведение колебательных свойств адсорбированных молекул



Рис. 1. Картины ДМЭ для пленок MgO толщиной 2 MLE, сформированных на поверхности Mo(100) (а) и Mo(110) (б), поддерживаемых при температуре 600 К. ACM-изображения пленок Au, нанесенных на поверхность MgO(111), поддерживаемой при комнатной температуре при покрытии Au 0.07 MLE (в) (размер растра 24 × 24 нм) и 3 MLE (г) (размер растра 2100×2100 нм).

СО, выступающих в роли пробных частиц. В качестве примера на рис. 2 приведены ИК-спектры при адсорбции молекул СО на поверхности кластеров Аи при покрытии 0.07 MLE на MgO(111) (спектр 2) и MgO(100) (спектр 1), поддерживаемых при температуре 90 К и экспозиции СО 50 L. Как видно, значения волновых чисел СО на поверхности Au/MgO(100) (кривая 1) и Au/MgO(111) (кривая 2) заметно различаются. В последнем случае наблюдается фиолетовый сдвиг на 17 см⁻¹. Принимая во внимание модель Блухолдера [9] хемосорбции СО на поверхности металлов, можно считать, что обратный перенос заряда от металла на разрыхляющую $2\pi^*$ -орбиталь молекулы CO для системы Au/MgO(111) меньше, чем для Au/MgO(100). Это может быть обусловлено меньшей плотностью валентного заряда Au, связанного с MgO(111). Причиной такого понижения величины валентного заряда Аи может быть его пе-MgO(111) ренос в сторону как способ стабилизации некомпенсированного дипольного момента этой полярной грани [10]. Это приводит к тому, что кластеры Аи малых размеров (2–3 нм) на поверхности MgO(111) приобретают эффективный положительный заряд. Подобная ситуация наблюдается и в ряде работ, рассмотренных в обзоре Нилиуса [7]. Например, кластеры Аи на поверхности полярной грани пленки FeO(111) приобретают положительный заряд в результате электронного переноса с Аи 6*s*-уровня в подложку. Это является, как указывает автор, наиболее эффективным способом стабилизации полярной поверхности оксида. В случае же неполярных подложек, например, MgO(100) или Al₂O₃(1000), кластеры Аи приобретают отрицательный заряд вследствие соответствующего перераспределения электронной плотности между анионом кислорода и металлом при образовании хемосорбционной связи [7, 8]. Ситуация, подобная последней, реализуется и для кластеров Au на поверхности



Рис. 2. Инфракрасные фурье-спектры в области внутримолекулярных колебаний молекул CO, адсорбированных на поверхности систем Au/MgO(100) (I), Au/MgO(111) (2) и после адсорбции кислорода на поверхность системы CO/Au/MgO(111) (3). Во всех случаях адсорбция молекул газов осуществлялась при температуре подложки 90 К. Экспозиция CO и O₂ составляет 50 и 100 L соответственно. На вставке приведены ИК-спектры, соответствующие экспозиции CO на предварительно выдержанной в атмосфере NO до экспозиции 100 L системе Au/MgO(111) (спектр I') при 90 К. Спектр 2' соответствует этой же системе после ее отжига до температуры 300 К.

MgO(100) с высокой плотностью анионных вакансий (F-центров) [11]. Внутримолекулярная колебательная частота молекул CO, адсорбированных на поверхности такой системы смещена в красную область по сравнению со случаем, когда в качестве оксидной подложки использована поверхность бездефектного кристалла MgO(100). Такое красное смещение, как указывают авторы [11], свидетельствует о более эффективном заполнении разрыхляющей $2\pi^*$ -орбитали CO отрицательно заряженным кластером Au, связанным с F-центром.

Для изучения возможных проявлений состояния кластеров Аи на полярной поверхности MgO(111), с точки зрения реализации тех или иных превращений адсорбированных молекул, системы CO/Au/MgO подвергались воздействию кислорода посредством контролируемого заполнения СВВ-камеры до парциального давления не выше 10⁻⁶ Торр. На рис. 2 приведен ИК-спектр, соответствующий насыщающей экспозиции кислорода 100 L на поверхности системы CO/Au/MgO(111), поддерживаемой при температуре 90 К (спектр 3). Очевидной особенностью при этом является сдвиг колебательного волнового числа СО от 2133 до 2140 см⁻¹. Такой фиолетовый сдвиг величины λ свидетельствует о том, что соадсорбция кислорода приводит к дальнейшему понижению электронной плотности на разрыхляющей орбитали 2^π CO. Для объяснения такого



Рис. 3. Термодесорбционные спектры CO_2 (m/z = 44), соответствующие системам (O_2+CO) на поверхности MgO(100) (1) и MgO(111) (2), зарегистрированные при поддержании парциального давления кислорода на уровне 10^{-6} Торр и скорости роста температуры образца 2 К/с; а также термодесорбционные спектры CO_2 , соответствующие системам, образованным адсорбцией 100 L CO на предварительно выдержанных в атмосфере NO до экспозиции 100 L системам Au/MgO(111) (3) и Au/MgO(100) (4), поддерживаемым при температуре 90 К. Спектр 5 соответствует m/z = 28 (CO), сопровождающему сигнал CO₂ для системы Au/MgO(111) (спектр 3).

сдвига волнового числа можно предположить, что происходит диссоциативная адсорбция кислорода, так что электронная плотность с орбитали $2\pi^*$ смещается в сторону более электроотрицательного уровня О 2*p* по механизму, предложенному в работе [12].

Термодесорбционные спектры, соответствующие величине m/z = 44 (CO₂) для соадсорбированной системы (О2+СО)/Аи на поверхности MgO(100) (спектр 1) и MgO(111) (спектр 2), зарегистрированные при парциальном давлении кислорода 10⁻⁶ Торр и при скорости роста температуры 2 К/с, приведены на рис. 3. Как видно, наноразмерные кластеры золота, нанесенные на обе подложки, активны в плане окисления молекул СО, хотя эффективность системы с участием MgO(111) существенно выше. Это обусловлено особыми свойствами, которые частицы Аи приобретают на поверхности полярной подложки, в частности, их эффективным положительным зарядом. Последнее, по данным [13, 14], приводит к более эффективному притяжению молекулярной орбитали СО 4 ок положительно заряженной частице Аи. Это, наряду с довольно интенсивным взаимодействием адсорбированной молекулы СО с кислородом, проявляемым в сдвиге волнового числа СО при соадсорбции с О₂ (рис. 2, спектр 3), приводит к образованию интермедиата, преобразующегося в СО2 при дальнейшей термической активации.

Особенности, отличающие наноразмерные кластеры Au на поверхности MgO(111) от массивных металлических адсорбентов, проявляются и

при совместной адсорбции молекул СО и NO. ИК-спектр, соответствующий системе, образованной адсорбцией СО на предварительно выдержанной в атмосфере NO до экспозиции 100 L системе Au/MgO(111), приведен на рис. 2 (вставка, спектр 1). Наблюдаются две основные линии поглощения в спектральных областях, соответствующих внутримолекулярным колебаниям NO (1520 см⁻¹) и СО (2040 см⁻¹), причем для СО наблюдается фиолетовый сдвиг по сравнению с величиной, характерной для адсорбции на поверхности кристаллов золота различной атомной структуры [15, 16]. Последнее может быть связано с указанным выше эффективным положительным зарядом нанесенных на MgO(111) наноразмерных кластеров золота, снижающим эффект заполнения разрыхляющей молекулярной 2π*орбитали. Для NO, наоборот, частота молекулярных колебаний, хотя и в меньшей степени, но смещена в красную область.

Такое различие может быть связано с различием кратности связи в молекулах СО и NO и ее трансформацией при хемосорбции [17]. Прогрев системы усиливает данную тенденцию, приводя к дальнейшему красному сдвигу частоты колебаний NO, сопровождающему процесс ослабления внутримолекулярной связи и, в конечном итоге, диссоциацию молекулы. Выделяющийся при этом кислород, как и в описанном выше случае (СО+О₂), приводит к окислению соадсорбированных молекул СО. Об этом свидетельствует соответствующий термодесорбционный спектр, основной сигнал которого -m/z = 44 (CO₂) (рис. 3, спектр 3). Такая же ситуация имеет место и для кластеров Аи близкой морфологии на поверхности MgO(100), однако в этом случае, как видно из соответствующего термодесорбционного спектра (рис. 3, спектр 4), эффективность окисления заметно меньше. Такое различие может быть связано с разным состоянием частиц Аи на поверхности MgO(111) и MgO(100), а также с более эффективным процессом диссоциации NO за счет более активной аккомодации образующихся атомов N как реализации механизма стабилизации полярной поверхности MgO(111). Последнее, в свою очередь, может приводить к изменению состояния частиц Аи на поверхности и, как следствие, к снижению эффективности процесса окисления СО за счет молекул NO. Об этом свидетельствуют, в частности, довольно заметные сигналы СО в термодесорбционном (рис. 3, спектр 5) и инфракрасном (рис. 2, вставка, спектр 2) спектрах, сохраняющиеся после реализации процесса взаимодействия (NO+CO).

Таким образом, частицы золота размером 2– 3 нм, нанесенные на поверхность пленки MgO(111), приобретают эффективный положительный заряд в результате переноса электронной плотности в сторону подложки для стабилизации некомпенсированного дипольного момента полярной поверхности MgO(111). Такое состояние данной металлооксидной системы проявляется в более эффективном процессе окисления молекул СО как кислородом, так и соадсорбированными молекулами NO, по сравнению с системой с участием неполярной поверхности MgO(100).

Работа выполнена при поддержке госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект СОГУ № 3.9281.2018) и Российского научного фонда в рамках проекта № 19-47-02010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Zhang J., Medlin J.W. // Surf. Sci. Rep. 2018. V. 73. № 4. P. 117.
- Picone A., Riva M., Brambilla A. et al. // Surf. Sci. Rep. 2016. V. 71. № 1. P. 32.
- Nilius N., Cörper A., Bozdech G. et al. // Progr. Surf. Sci. 2011. V. 67. № 1. P. 99.
- Xue M., Guo Q. // J. Chem. Phys. 2007. V. 127. № 8. P. 054705.

- 5. *He J.-W., Estrada C.A., Corneille J.S. et al.* // Surf. Sci. 1992. V. 261 № 1. P. 164.
- 6. *Grigorkina G.S., Ramonova A.G., Kibizov D.D. et al.* // Solid State Commun. 2017. V. 257. № 1. P. 16.
- 7. Nilius N. // Surf. Sci. Rep. 2009. V. 64. № 12. P. 595.
- Giordano L., Pacchioni G. // Accounts Chem. Res. 2011. V. 44. № 11. P. 1244.
- 9. Blyholder G. // J. Phys. Chem. 1964. V. 68. № 1. P. 277.
- Goniakowski J., Noguera C. // Phys. Rev. B. 1999. V. 60. № 7. P. 16120.
- 11. Woon B., Hakkinen H., Landman U. et al. // Science. 2005. V. 307. P. 403.
- 12. Doyen G., Ertl G. // Surf. Sci. 1974. V. 43. № 1. P. 197.
- 13. *Ferullo R.M., Fuente S.A., Belelli P.G. et al.* // Surf. Sci. 2009. V. 603. № 4. P. 1262.
- 14. L. Giordano L., Vitto A.D., Pacchioni G., Ferrari A.M. // Surf. Sci. 2003. V. 540 № 1. P. 63.
- 15. *Carabineiro S.A.C., Nieuwenhuys B.E.* // Gold Bulletin. 2009. V. 42. № 1. P. 288.
- Hoffmann F.M. // Surf. Sci. Rep. 1983. V. 3. № 2–3. P. 107.
- Zhdanov V.P., Kasemo B. // Surf. Sci. Rep. 1997. V. 29. № 2. P. 31.